

PNPエピタキシャル形シリコン トランジスタ (6ピン2回路)
低周波増幅用

μ PA671Tは、トランジスタを2回路内蔵したミニモールドデバイスであり、実装密度の向上、実装コストの削減に貢献します。

特 徴

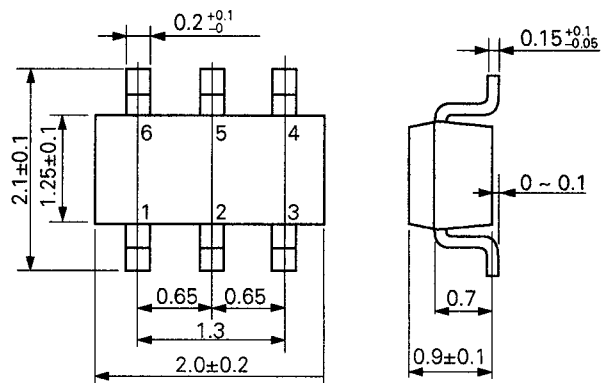
- SC-70パッケージと同じサイズのパッケージにトランジスタを2回路内蔵
- μ PA670Tとコンプリメンタリで使用可能
- 自動実装対応

品質水準

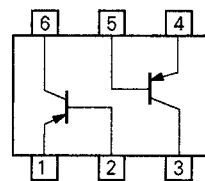
標準 (一般電子機器用)

品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料「NEC半導体デバイスの品質水準」(IEI-620)をご覧ください。

外形図 (単位: mm)



端子接続 (Top View)



1. エミッタ (E1)
2. ベース (B1)
3. コレクタ (C2)
4. エミッタ (E2)
5. ベース (B2)
6. コレクタ (C1)

捺印: LA

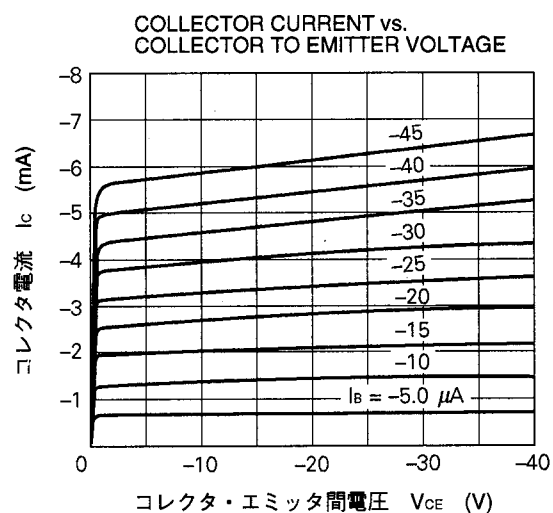
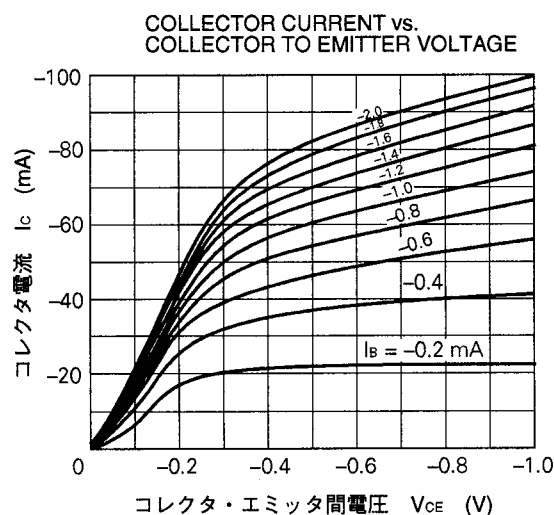
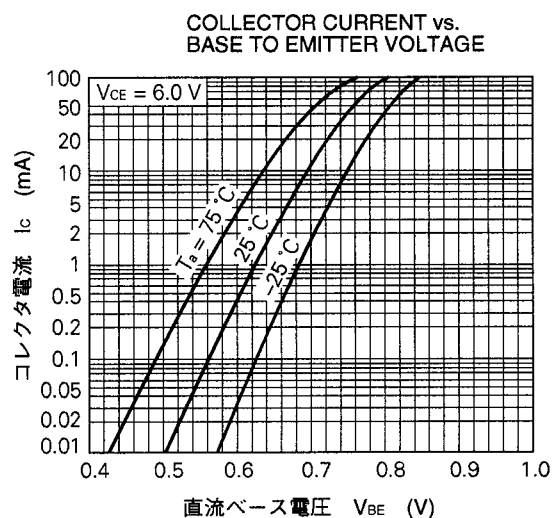
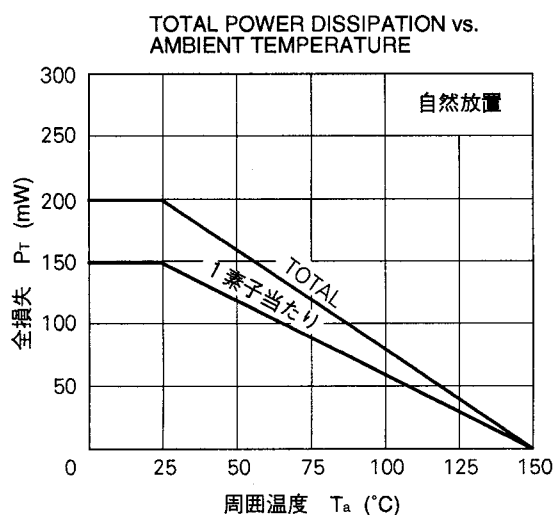
絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

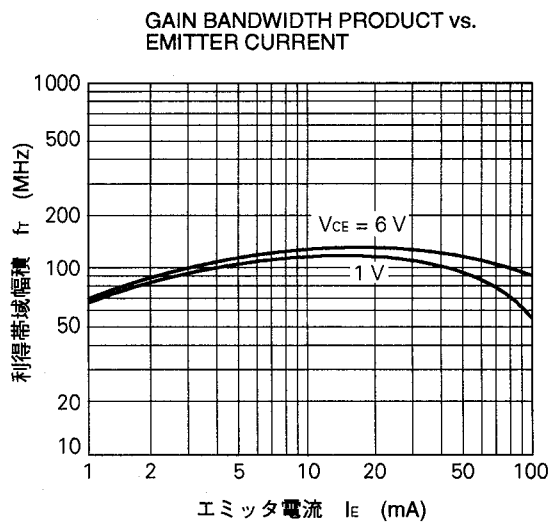
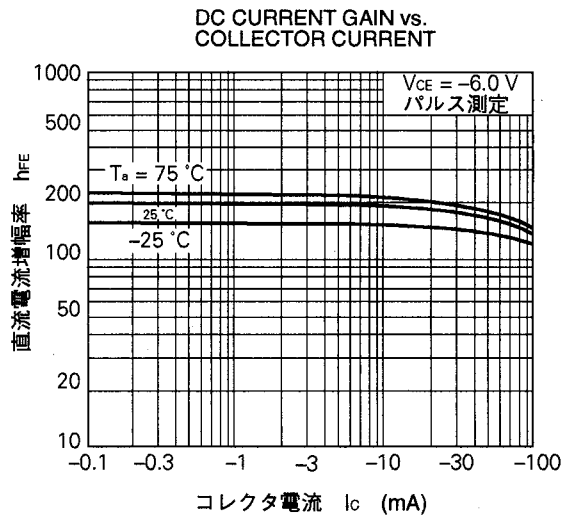
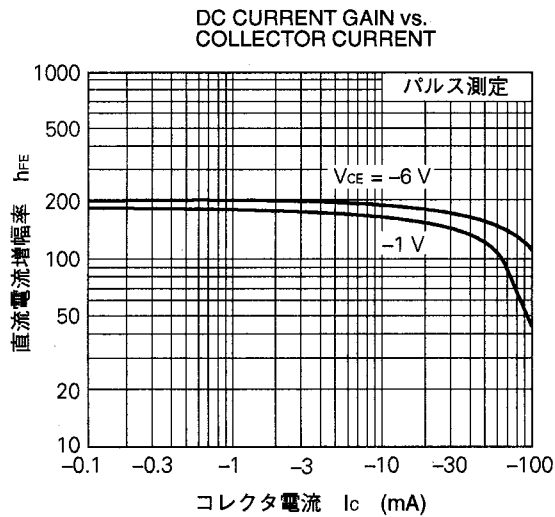
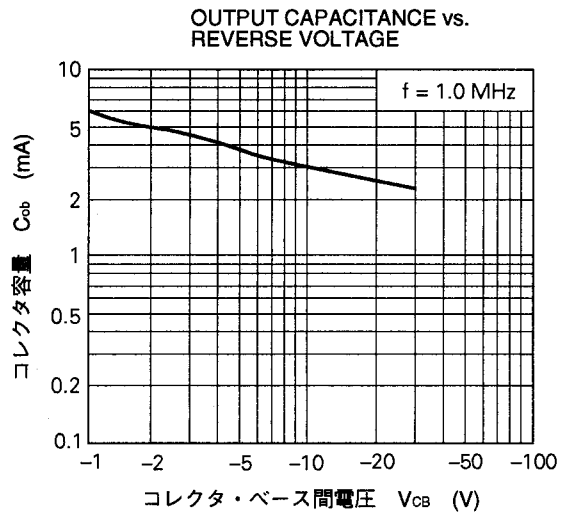
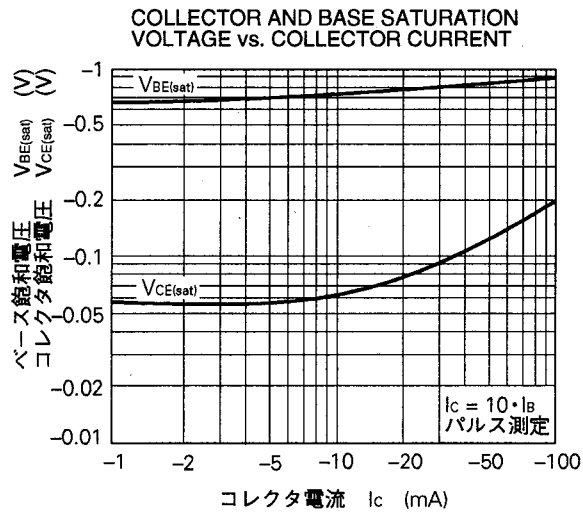
項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}		-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	$V_{BE} = 0$	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	$V_{CE} = 0$	-5.0	V
コレクタ電流 (直流)	$I_{C(DC)}$		-100	mA
コレクタ電流 (パルス)	$I_{C(pulse)}$	$PW \leq 10 \text{ ms}, \text{Duty Cycle} \leq 50 \%$	-200	mA
全 損 失	P_T		200 (TOTAL)	mW
ジャンクション温度	T_j		150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{slg}		-55~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -60\text{ V}, I_E = 0$			-100	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0\text{ V}, I_C = 0$			-100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1}	$V_{CE} = -6.0\text{ V}, I_C = -0.1\text{ mA}$	50			-
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2}	$V_{CE} = -6.0\text{ V}, I_C = -1.0\text{ mA}$	90		600	-
直 流 ベ ー ス 電 圧	$V_{BE(on)}$	$V_{CE} = -6.0\text{ V}, I_C = -1.0\text{ mA}$		-0.62		V
コ レ ク タ 飽 和 電 圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100\text{ mA}, I_B = -10\text{ mA}$		-0.18	-0.30	V
ベ ー ス 飽 和 電 圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -100\text{ mA}, I_B = -10\text{ mA}$		-0.86	-1.00	V
利 得 帯 域 幅 積	f_T	$V_{CE} = -6.0\text{ V}, I_E = 10\text{ mA}$	50	180		MHz
コ レ ク タ 容 量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 0, f = 1.0\text{ MHz}$		4.5	6.0	pF

特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)





関連技術資料一覧

資 料 名	資 料 番 号
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
パルス電力損失時におけるトランジスタの 接合部温度の算出方法について	TEB-528
トランジスタのE-B接合ブレイクダウンによる h _{FE} ノイズ劣化	TEB-537
NEC半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
- 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
- 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
- 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

お問い合わせは、最寄りのNECへ

本 社	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)
コンシューマ半導体販売事業部	
OA半導体販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)
インダストリアル半導体販売事業部	東京 (03)3454-1111
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)
	名古屋 (052)242-2755
関西支社 半導体販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)
	大阪 (06)945-3178
	大阪 (06)945-3200
	大阪 (06)945-3208

北海道支社	札幌 (011)231-0161
東北支社	仙台 (022)261-5511
北支社	(0196)51-4344
山形支社	(0236)23-5511
茨城支社	(0249)23-5511
栃木支社	(0246)21-5511
群馬支社	(0258)36-2155
長野支社	(0292)26-1717
新潟支社	(045)324-5511
富山支社	(0273)26-1255
石川支社	(0276)46-4011
福井支社	(0286)21-2281
山梨支社	(0285)24-5011
長野支社	(0262)35-1444
山梨支社	(0263)35-1666
長野支社	(0266)53-5350
長野支社	(0552)24-4141
長野支社	(048)641-1411
立川支社	(0425)26-5981
立川支社	(043)238-8116
立川支社	(054)255-2211
立川支社	(0559)63-4455
立川支社	(053)452-2711
立川支社	(0762)23-1621
立川支社	(0776)22-1866
立川支社	(0764)31-8461
立川支社	(075)344-7824
立川支社	(078)332-3311
立川支社	(082)242-5504
立川支社	(0857)27-5311
立川支社	(086)225-4455
立川支社	(0878)36-1200
立川支社	(0897)32-5001
立川支社	(0899)45-4111
立川支社	(092)271-7700
立川支社	(093)541-2887

(技術お問い合わせ先)

半導体応用技術本部 汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川 崎 (044)548-7914	半導体応用技術本部
半導体応用技術本部 中部応用システム技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2762	インフォメーションセンター
半導体応用技術本部 西日本応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大 阪 (06)945-3383	FAX(044)548-7900
			(FAXで対応させていただきます)